

CS39-4B
 CS39-4D
 CS39-4M
 CS39-4N

**SILICON CONTROLLED RECTIFIER
 4 AMP, 200 THRU 800 VOLTS**



TO-39 CASE



www.centralemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CS39-4B series types are hermetically sealed silicon controlled rectifiers designed for sensing circuit applications and control systems.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

| | SYMBOL | CS39 <u>-4B</u> | CS39 <u>-4D</u> | CS39 <u>-4M</u> | CS39 <u>-4N</u> | UNITS |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Peak Repetitive Off-State Voltage | V_{DRM}, V_{RRM} | 200 | 400 | 600 | 800 | V |
| RMS On-State Current ($T_C=90^\circ\text{C}$) | $I_T(\text{RMS})$ | | | 4.0 | | A |
| Peak One Cycle Surge Current ($t=10\text{ms}$) | I_{TSM} | | | 35 | | A |
| I^2t Value for Fusing ($t=10\text{ms}$) | I^2t | | | 4.5 | | A^2s |
| Peak Gate Power Dissipation ($t_p=10\mu\text{s}$) | P_{GM} | | | 3.0 | | W |
| Average Gate Power Dissipation | $P_{G(AV)}$ | | | 0.2 | | W |
| Peak Gate Current ($t_p=10\mu\text{s}$) | I_{GM} | | | 1.2 | | A |
| Operating Junction Temperature | T_J | | -40 to +125 | | | $^\circ\text{C}$ |
| Storage Temperature | T_{stg} | | -65 to +150 | | | $^\circ\text{C}$ |
| Thermal Resistance | θ_{JA} | | 180 | | | $^\circ\text{C/W}$ |
| Thermal Resistance | θ_{JC} | | 10 | | | $^\circ\text{C/W}$ |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

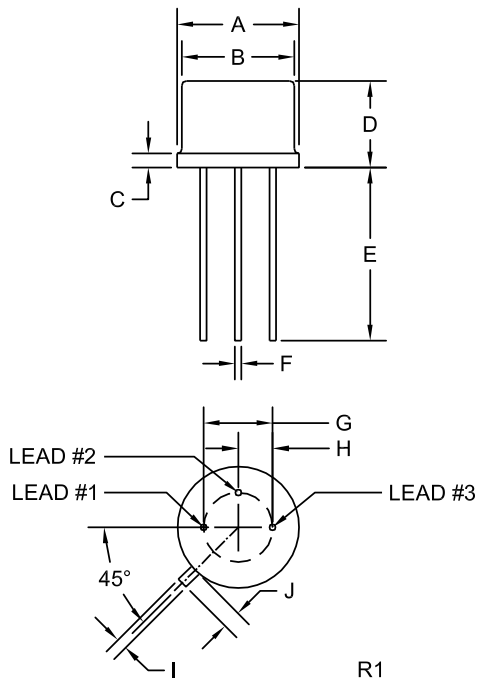
| SYMBOL | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------------|
| I_{DRM}, I_{RRM} | Rated $V_{DRM}, V_{RRM}, R_{GK}=1.0\text{K}\Omega$ | | | 5.0 | μA |
| I_{DRM}, I_{RRM} | Rated $V_{DRM}, V_{RRM}, R_{GK}=1.0\text{K}\Omega, T_C=125^\circ\text{C}$ | | | 200 | μA |
| I_{GT} | $V_D=12\text{V}, R_L=10\Omega$ | | 38 | 200 | μA |
| I_H | $I_T=50\text{mA}, R_{GK}=1.0\text{K}\Omega$ | | 0.25 | 5.0 | mA |
| V_{GT} | $V_D=12\text{V}, R_L=10\Omega$ | | 0.55 | 0.8 | V |
| V_{GD} | $V_D=300\text{V}, R_{GK}=1.0\text{K}\Omega, T_C=125^\circ\text{C}$ | 0.2 | | | V |
| V_{TM} | $I_T=8.0\text{A}, t_p=380\mu\text{s}$ | | 1.6 | 1.95 | V |
| dv/dt | $V_D=2/3V_{DRM}, R_{GK}=1.0\text{K}\Omega, T_C=125^\circ\text{C}$ | 10 | | | V/ μs |

CS39-4B
 CS39-4D
 CS39-4M
 CS39-4N

SILICON CONTROLLED RECTIFIER
 4 AMP, 200 THRU 800 VOLTS



TO-39 CASE - MECHANICAL OUTLINE



| SYMBOL | INCHES | | MILLIMETERS | |
|---------|--------|-------|-------------|------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX |
| A (DIA) | 0.335 | 0.370 | 8.51 | 9.40 |
| B (DIA) | 0.315 | 0.335 | 8.00 | 8.51 |
| C | - | 0.040 | - | 1.02 |
| D | 0.240 | 0.260 | 6.10 | 6.60 |
| E | 0.500 | - | 12.70 | - |
| F (DIA) | 0.016 | 0.021 | 0.41 | 0.53 |
| G (DIA) | 0.200 | | 5.08 | |
| H | 0.100 | | 2.54 | |
| I | 0.028 | 0.034 | 0.71 | 0.86 |
| J | 0.029 | 0.045 | 0.74 | 1.14 |

TO-39 (REV: R1)

LEAD CODE:

- 1) Cathode
- 2) Gate
- 3) Anode

MARKING: FULL PART NUMBER

R3 (19-September 2012)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.